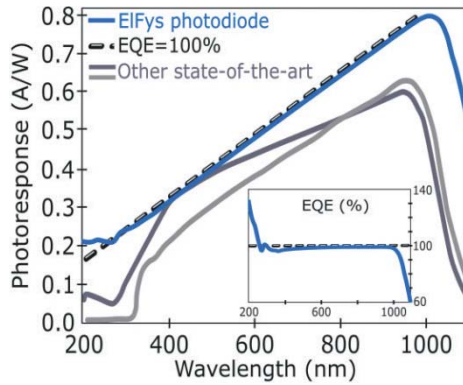
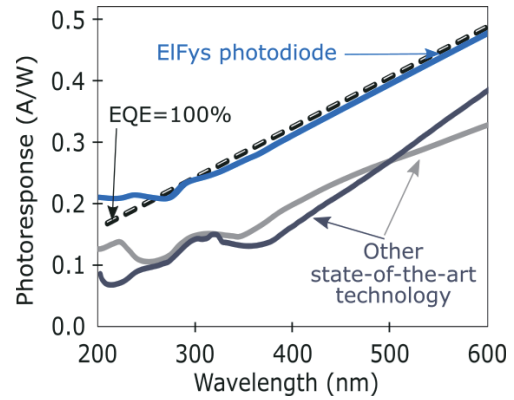


黑硅光电探测器

EIFys 提供一系列高性能黑硅光电二极管。该光电探测器是通过采用表面纳米结构技术与原子层沉积涂层相结合，大大提高了光收集效率。在 200 nm 至 950 nm 范围内具有近乎完美的光响应，外量子效率 $\geq 96\%$ （通过德国国家计量研究院PTB 认证）。

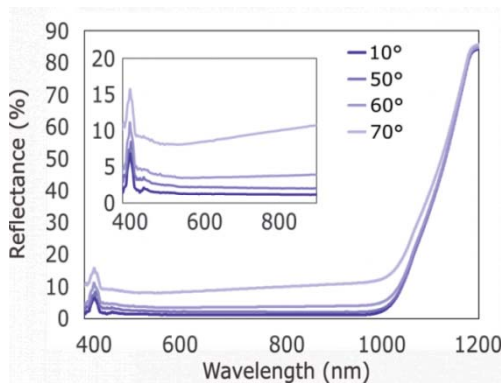


此光电探测器在紫外波段也同样具有极高的量子效率，比普通的硅光电二极管高出两倍以上。



黑硅表面与定制的原子层沉积涂层相结合，极大地提高了感应角度范围内的表面吸收率，

具有极高吸光度的超宽感应角度 ($> 95\%$ @ 60°)



EIFys 提供SM和PD两大系列的标准产品，也可以针对不同应用需求进行定制。

可以灵活地提供光电二极管芯片和完全封装的光电探测器解决方案。

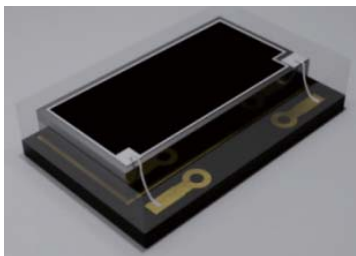
SM 系列

主要特点:

- 在多波长下具有出色的光敏性: 绿色、红色和 NIR
- 低暗电流
- 紧凑型 SMD 封装

典型应用:

- 健康监测
- 可穿戴电子产品



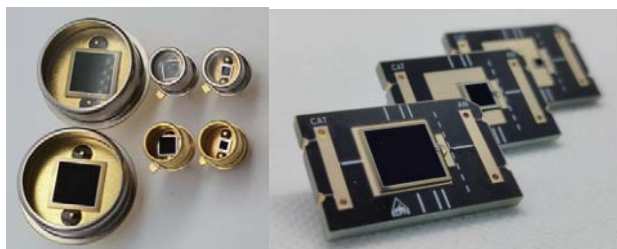
PD 系列

主要特点:

- 增强的广谱光敏性
- UV、Vis 和 NIR
- 优化的电气特性
- TO-can 封装最大程度保护环境

典型应用:

- 高精度测光
- 分析仪器
- X射线成像



选型:

产品系列	型号	最大偏置电压 [V]	感光面积 [mm ²]	最大暗电流 @ -10 mV [pA]	节电容 @0V,100kHz [pF]	响应率 @λp		默认封装 *
						[A/W]	λp (nm)	
SM	SM322	6	3.22	40	60	0.71	970	SMD
	SM446	6	4.46	50	80	0.71	970	SMD
PD	PD1sM	10	1	12	20	0.80	1010	TO-46
	PD1sH		1	255	11	0.81	1040	TO-46
	PD4sM	20	4	15	65	0.80	1010	TO-46
	PD25sM		25	30	370	0.80	1010	TO-8
	PD25sH		25	700	110	0.81	1040	TO-8
	PD100sM		100	60	1200	0.80	1010	PCB
	PD100sH	100	1500	340	0.81	1040	PCB	
	PD5sMG	100	5	15	105	0.80	1010	PCB
	PD5sHG		5	400	30	0.81	1040	PCB
	PD25sMG		25	30	370	0.80	1010	PCB
	PD25sHG		25	700	110	0.81	1040	PCB
	PD100sMG		100	60	1200	0.80	1010	PCB
PD100sHG	100		1500	340	0.81	1040	PCB	

可根据客户要求为所有产品提供定制封装。